









	<h2 style="color: #E67E22;">FDP038AN06A0-F102</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FDP038AN06A0-F102
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO220-3
	Datenblätter:  FDP038AN06A0-F102.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP038AN06A0-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FDP038AN06A0_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	124nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 80A (Tc) 310W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

FDP038AN06A0-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP038AN06A0-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP038AN06A0-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDP038AN06A0-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDP038AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB	 FDP038AN FAIRCHILD FDP038AN FAIRCHILD	 FDP039N08B FSC FDP039N08B FSC	 FDP038AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB
 FDP038AN06A0 FSC FDP038AN06A0 FSC	 FDP040N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220	 FDP036N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3	 FDP039N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 120A TO-220

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP038AN06A0-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDP038AN06A0-F102 Datenblatt	FDP038AN06A0-F102-Datenblätter	FDP038AN06A0-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDP038AN06A0-F102
FDP038AN06A0-F102 Electronic	FDP038AN06A0-F102-Komponenten	FDP038AN06A0-F102-Verteiler	FDP038AN06A0-F102-Bild	FDP038AN06A0-F102-Teil
FDP038AN06A0-F102 Preis	FDP038AN06A0-F102 Hersteller	FDP038AN06A0-F102 Bild	FDP038AN06A0-F102 Aktie	FDP038AN06A0-F102 Inventar
FDP038AN06A0-F102 Neu	FDP038AN06A0-F102 Original	FDP038AN06A0-F102 garantiert	FDP038AN06A0-F102 RFQ	FDP038AN06A0-F102 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited